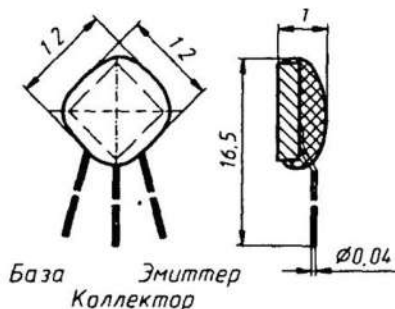


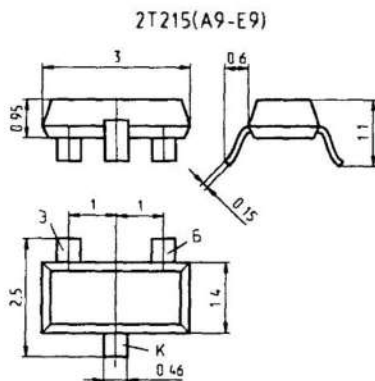
**2Т215А9, 2Т215В9, 2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215Д9,  
2Т215Е9, 2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1,  
2Т215Д-1, 2Т215Е-1, КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1,  
КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n*. Предназначены для использования в усилителях и переключающих устройствах герметизированной аппаратуры. Транзисторы 2Т215(А9-Е9) выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами, 2Т215(А-1-Е-1), КТ215(А-1-Е-1) — бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием. Тип прибора указывается в этикетке и на таре-спутнике.



Е-1) — бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием. Тип прибора указывается в этикетке и на таре-спутнике.

Масса транзистора в пластмассовом корпусе не более 0,1 г, бескорпусного не более 0,01 г.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при  $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $U_{\text{КБ}} = 5\text{ В}$ ,  $I_3 = 10\text{ мА}$ :

2Т215А9, 2Т215А-1, КТ215А-1, не менее .....	20
2Т215В9, 2Т215Б-1, КТ215Б-1 .....	30...90
2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, КТ215В-1, КТ215Г-1 .....	40...120

$U_{\text{КБ}} = 1\text{ В}$ ,  $I_3 = 40\text{ мкА}$ , не менее:

2Т215Д9, 2Т215Д-1, КТ215Д-1 .....	80
-----------------------------------	----

2Т215Е9, 2Т215Е-1, КТ215Е-1 .....	40
при $T = T_{\text{МАКС}}$ , $U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$ , $I_3 = 10 \text{ мА}$ :	
2Т215А9, 2Т215А-1, КТ215А-1, не менее .....	20
2Т215Б9, 2Т215Б-1, КТ215Б-1 .....	30...150
2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, КТ215В-1, КТ215Г-1 .....	40...200
$U_{\text{КБ}} = 1 \text{ В}$ , $I_3 = 40 \text{ мкА}$ , не менее:	
2Т215Д9, 2Т215Д-1, КТ215Д-1 .....	80
2Т215Е9, 2Т215Е-1, КТ215Е-1 .....	40
при $T = T_{\text{МИН}}$ , $U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$ , $I_3 = 10 \text{ мА}$ :	
2Т215А9, 2Т215А-1, КТ215А-1, не менее .....	7
2Т215Б9, 2Т215Б-1, КТ215Б-1 .....	10...90
2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, КТ215В-1, КТ215Г-1 .....	15...120
$U_{\text{КБ}} = 1 \text{ В}$ , $I_3 = 40 \text{ мкА}$ , не менее:	
2Т215Д9, 2Т215Д-1, КТ215Д-1 .....	25
2Т215Е9, 2Т215Е-1, КТ215Е-1 .....	15
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$ , $I_3 = 1 \text{ мА}$ , не менее .....	5 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$ , $I_3 = 2 \text{ мА}$ , не более .....	5 нс
Коэффициент шума на $f = 1 \text{ кГц}$ при $U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$ , $I_3 = 40 \text{ мкА}$ , $R_T = 10 \text{ кОм}$ для 2Т215Д9, 2Т215Д-1, КТ215Д-1, не более .....	5* дБ
Граничное напряжение при $I_k = 10 \text{ мА}$ , не менее:	
2Т215А9, 2Т215Б9, 2Т215А-1, 2Т215Б-1, КТ215А-1, КТ215Б-1 .....	80 В
2Т215В9, 2Т215В-1, КТ215В-1 .....	60 В
2Т215Г9, 2Т215Г-1, КТ215Г-1 .....	40 В
2Т215Д9, 2Т215Д-1, КТ215Д-1 .....	30 В
2Т215Е9, 2Т215Е-1, КТ215Е-1 .....	20 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 10 \text{ мА}$ , $I_3 = 1 \text{ мА}$ , не более:	
2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 2Т215Е-1 .....	0,45 В
2Т215А9, 2Т215Б9, 2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215Д9, 2Т215Е9, КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1 .....	0,6 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 10 \text{ А}$ , $I_B = 1 \text{ мА}$ , не более .....	1,2* В
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ, \text{МАКС}}$ , $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$ , не более:	
$T = +25 \text{ °С}$ и $T = T_{\text{МИН}}$ .....	1 мкА
$T = T_{\text{МАКС}}$ .....	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{КЭ} = U_{КЭ, \text{МАКС}}$ не более .....	10 мкА
Входное сопротивление в схеме ОЭ в режиме малого сигнала при $U_{КЭ} = 5 \text{ В}$ , $I_K = 2 \text{ мА}$ .....	1,2*...1,5*... 10* кОм
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$ .....	9,5*...12*... 50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5 \text{ В}$ .....	9,6*...40*... 100 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$ :	
2Т215А9, 2Т215А-1, КТ215А-1 .....	100 В
2Т215Б9, 2Т215Б-1, КТ215Б-1 .....	90 В
2Т215В9, 2Т215В-1, КТ215В-1 .....	80 В
2Т215Г9, 2Т215Г-1, КТ215Г-1 .....	60 В
2Т215Д9, 2Т215Е9, 2Т215Д-1, 2Т215Е-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1 .....	30 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	5 В
Постоянный ток коллектора .....	50 мА
Импульсный ток коллектора при $t_n = 10 \text{ мкс}$ , $Q = 100$ .....	100 мА
Постоянный ток базы .....	20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора <sup>1</sup> :	
при $T = T_{\text{МИН}}...+25 \text{ °С}$ :	
2Т215А9, 2Т215Б9, 2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215Д9, 2Т215Е9 .....	200 мВт
2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 2Т215Е-1, КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1 .....	50 мВт

<sup>1</sup> При  $T > +25 \text{ °С}$  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора уменьшается линейно.

при  $T = T_{\text{МАКС}}$

2Т215А9, 2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215Д9, 2Т215Е9 .....	80 мВт
2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 2Т215Е-1, КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1 .....	20 мВт

Тепловое сопротивление переход—среда:

2Т215А9, 2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215Д9, 2Т215Е9 .....	0,5 °С/мВт
2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 2Т215Е-1, КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1 .....	2 °С/мВт

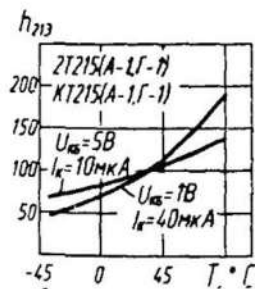
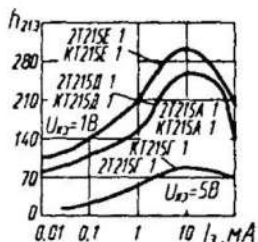
Температура р-п перехода ..... +125 °С

Температура окружающей среды:

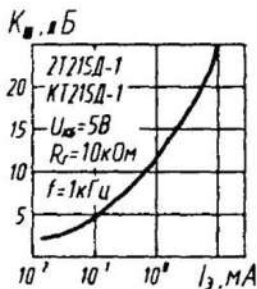
2Т215А9, 2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215Д9, 2Т215Е9 .....	-60...+85 °С
2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 2Т215Е-1 .....	-60...+100 °С
КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1 .....	-45...+85 °С

Зависимости электрических параметров от токов, температуры и сопротивления генератора для 2Т215(А9—Е9) аналогичны зависимостям 2Т215(А-1—Е-1).

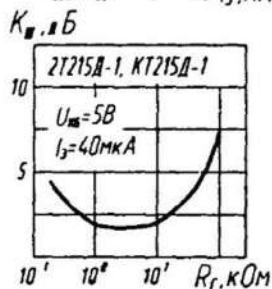
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



Зависимость коэффициента шума от тока эмиттера



Зависимость коэффициента шума от сопротивления генератора